

**Влияние дефектов эпитаксиального слоя на напряжение пробоя высоковольтных арсенид-галлиевых структур**

Aškinazi, G.; Zolotarevskaja, O.; **Meiler, Boriss** Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1978 / с. 64-66 : илл

[https://www.ester.ee/record=b1262177\\*est](https://www.ester.ee/record=b1262177*est)

**Приближенный метод исследования переноса неравновесных носителей заряда в варизонных полупроводниках с учетом перепоглощения рекомбинационного излучения**

**Velme, Enn** Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 12-14 [https://www.ester.ee/record=b1262177\\*est](https://www.ester.ee/record=b1262177*est)

**Рост и морфология толстых слоев арсенида галлия, выращенных жидкофазной эпитаксией**

**Meiler, Boriss**; Zolotarevski, L.; **Paat, Aadu**; Orenštein, I. Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 24-26

[https://www.ester.ee/record=b1262177\\*est](https://www.ester.ee/record=b1262177*est)

**Фотолюминесценция гетероструктур на основе сульфида кадмия**

**Erm, Ants; Krunks, Malle; Piibe, Toomas; Mellikov, Enn** Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 41-43 :

илл [https://www.ester.ee/record=b1262177\\*est](https://www.ester.ee/record=b1262177*est)

**Фотопреобразователи CdS - CU<sub>2</sub>S на основе пульверизованных пленок**

**Varema, Tiit; Iljina, Natalja; Krunks, Malle; Terasmaa, P.; Mellikov, Enn**; Karpenko, I.V. Полупроводники и гетеропереходы :

сборник статей 1987 / с. 43-46 : ил [https://www.ester.ee/record=b1262177\\*est](https://www.ester.ee/record=b1262177*est)